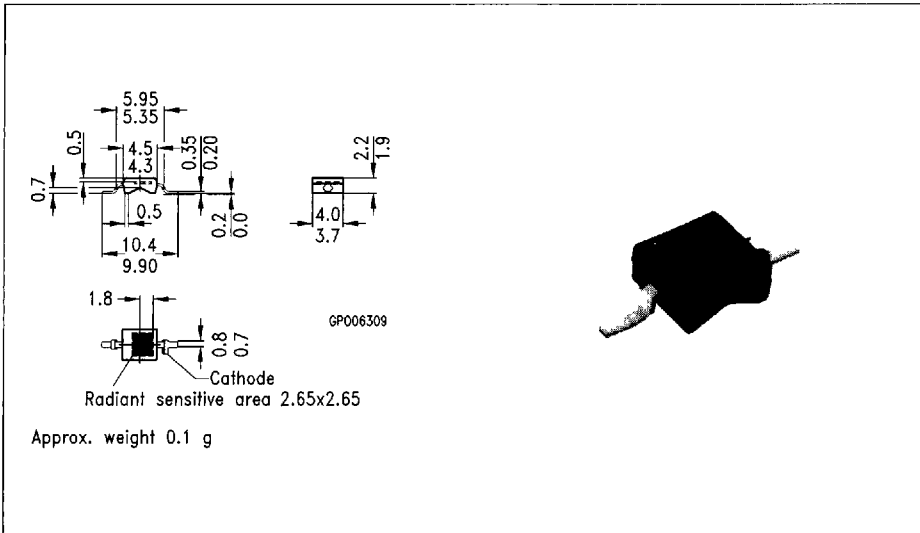


## Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter

BP 104 BS



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
- kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- SMT-Plastikbauform für Handlötung mit hoher Packungsdichte
- Auslauftyp, Ersatz: BPW 34 FS ab 4/95

### Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

### Features

- Especially suitable for applications of 950 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- SMT plastic package with high packing density
- Replacement: BPW 34 FS as of 4/95

### Applications

- IR remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, remote controls of various equipment
- Light reflecting switches for steady or varying intensity

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
BP 104 BS	Q62702-P917	Leiterbandgehäuse, schwarzes Epoxy-Gießharz, Lötspieße im 5.08-mm Raster (2/10") Lead frame, black epoxy resin, solder tabs 5.08 mm (2/10") lead spacing

8235605 0057507 254

## Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... +80	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3s$ ) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ( $t \leq 3s$ )	$T_S$	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	32	V
Verlustleistung, $T_A = 25\text{ °C}$ Total power dissipation	$P_{tot}$	150	mW

## Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ , $\lambda = 950\text{ nm}$ ) Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5\text{ V}$ , $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$	$S$	25 ( $\geq 15$ )	$\mu\text{A}$
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	950	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von $S_{\text{max}}$ Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of $S_{\text{max}}$	$\lambda$	780 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	7.00	$\text{mm}^2$
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	2.65 x 2.65	mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	$H$	0.5	mm
Halbwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 60$	Grad deg.

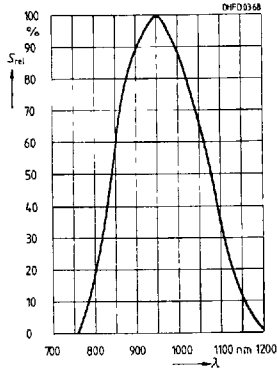
**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )

**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Dunkelstrom, $V_R = 10\text{ V}$ Dark current	$I_R$	2 ( $\leq 30$ )	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity	$S_\lambda$	0.59	A/W
Quantenausbeute Quantum yield	$\eta$	0.77	<u>Electrons</u> Photon
Leerlaufspannung, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ Open-circuit voltage	$V_L$	330 ( $\geq 275$ )	mV
Kurzschlußstrom, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ Short-circuit current	$I_K$	25	$\mu\text{A}$
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50\text{ k}\Omega$ ; $V_R = 5\text{ V}$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$ ; $I_p = 800\text{ }\mu\text{A}$	$t_r, t_f$	20	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 100\text{ mA}$ , $E = 0$ Forward voltage	$V_F$	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ Capacitance	$C_0$	72	pF
Temperaturkoeffizient von $V_L$ Temperature coefficient of $V_L$	$TC_V$	-2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_K$ Temperature coefficient of $I_K$	$TC_I$	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10\text{ V}$	$NEP$	$4.3 \times 10^{-14}$	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 10\text{ V}$ Detection limit	$D^*$	$6.2 \times 10^{12}$	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

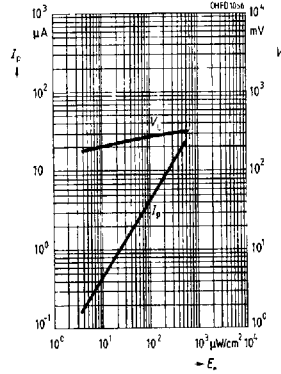
### Relative spectral sensitivity

$$S_{rel} = f(\lambda)$$

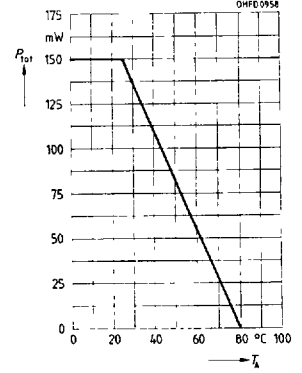


### Photocurrent $I_p = f(E_e), V_R = 5 \text{ V}$

$$\text{Open-circuit-voltage } V_L = f(E_e)$$

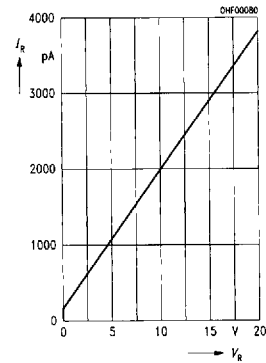


### Total power dissipation $P_{tot} = f(T_A)$



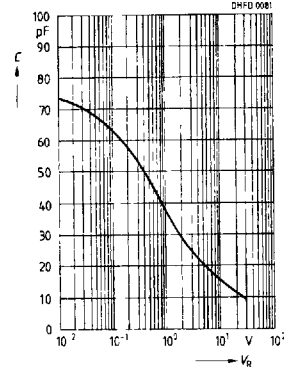
### Dark current

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



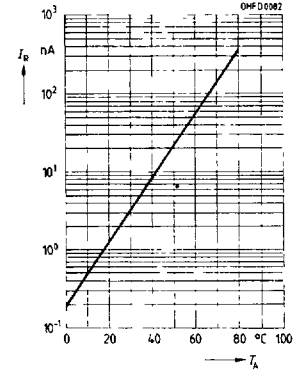
### Capacitance

$$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

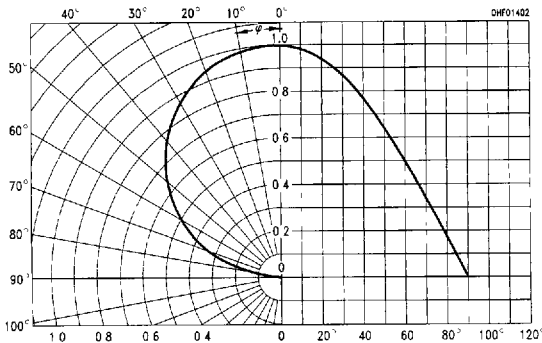


### Dark current

$$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$$



### Directional characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$



8235605 0057510 849